I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1662/83 DES RATES

vom 21. Juni 1983

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige Waren der Tarifstellen ex 84.55 C und ex 85.21 D II

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die dieser Verordnung unterfallenden Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen insbesondere eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1983 werden die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die in den Tabellen im Anhang aufgeführten Waren auf die dort jeweils angegebene Höhe ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1983 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 21. Juni 1983.

Im Namen des Rates

Der Präsident

H.-W. LAUTENSCHLAGER

ANHANG

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen elektronisch programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 128 K bit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind : — zwei elektronische programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 64 K bit und je einem Quarzfenster auf der Oberseite, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkoppelungskondensator. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen / Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält : EDH 7816 C-30 EDH 7816 C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht	2,5
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 64 K bit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind : — vier statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 K bit, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkoppelungskondensator. Das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält : EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 256 K bit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — vier statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 64 K bit, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkoppelungskondensator. Das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: EDH 8832 MC-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektronisch programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm, auf dem ein Decoder, ein Entkoppelungskondensator und zwei Chips mit einer Speicherkapazität von je 64 K bit und einer Gesamtspeicherkapazität von 128 K bit angebracht sind, mit zwei Quarzfenstern auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EDH 7816 C-30 EDH 7816 C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	8,5
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm, auf dem ein Decoder, ein Entkoppelungskondensator und vier Chips mit einer Speicherkapazität von je 16 K bit und einer Gesamtspeicherkapazität von 64 K bit angebracht sind mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen / Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm, auf dem ein Decoder, ein Entkoppelungskondensator und vier Chips mit einer Speicherkapazität von je 64 K bit und einer Gesamtspeicherkapazität von 256 K bit angebracht sind, mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: EDH 8832 MC-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0